

КТ3102Д

Транзисторы кремниевые, эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения в низкочастотных устройствах с малым уровнем шумов, переключающих, усилительных и генераторных устройствах средней и высокой частоты. Транзисторы КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Д, КТ3102Е выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.

Транзисторы маркируются на боковой поверхности корпуса.

Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзисторов не более 0,5 г.

Тип корпуса: КТ-1-7.

Технические условия: аА0.336.122 ТУ.

Характеристики транзисторов КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, КТ3102Д, КТ3102Е, КТ3102Ж, КТ3102И, КТ3102К:

Тип транзистора	Структура	Предельные значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						Значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						$T_{п\text{ max}}$ °C	$T_{\text{ max}}$ °C	
		$I_{к\text{ max}}$	$I_{к\text{ и. max}}$	$U_{кэ0}$	$U_{кб0}$	$U_{эб0}$	$R_{к\text{ max}}$	$h_{21Э}$	$U_{к\text{ э на с.}}$	$I_{кб0}$	$f_{гр.}$	$K_{ш}$	$C_{к}$			$C_{э}$
		мА	мА	В	В	В	мВ _т		В	мкА	МГц	дБ	пФ			пФ
КТ3102А	n-p-n	100	200	50	50	5	250	100...250	-	0,05	300	10	6	-	125	-40...+85
КТ3102Б	n-p-n	100	200	50	50	5	250	200...500	-	0,05	300	10	6	-	125	-40...+85
КТ3102В	n-p-n	100	200	30	30	5	250	200...500	-	0,015	300	10	6	-	125	-40...+85
КТ3102Г	n-p-n	100	200	20	20	5	250	400...1000	-	0,015	300	10	6	-	125	-40...+85
КТ3102Д	n-p-n	100	200	30	30	5	250	200...500	-	0,015	300	4	6	-	125	-40...+85
КТ3102Е	n-p-n	100	200	20	20	5	250	400...1000	-	0,015	300	4	6	-	125	-40...+85
КТ3102Ж	n-p-n	100	200	50	50	5	250	100...250	-	0,05	300	-	6	-	125	-40...+85
КТ3102И	n-p-n	100	200	50	50	5	250	200...500	-	0,05	300	-	6	-	12	-

		0	0				0	0						5	40...+ 85	
КТ3102К	n-p-n	10 0	20 0	30	30	5	25 0	200...50 0	-	0,01 5	300	-	6	-	12 5	- 40...+ 85

Условные обозначения электрических параметров транзисторов:

- **$I_k \max$** - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
- **$I_k \text{ и. } \max$** - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
- **$U_{кэR} \max$** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- **$U_{кэ0} \max$** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
- **$U_{кб0} \max$** - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
- **$U_{эб0} \max$** - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
- **$P_k \max$** - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- **$P_k \text{ и. } \max$** - максимально допустимая импульсная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- **$h_{21Э}$** - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
- **$h_{21э}$** - коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером.
- **$U_{кэ \text{ нас.}}$** - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
- **$I_{кб0}$** - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
- **$f_{гр}$** - граничная частота коэффициента передачи тока.
- **$f_{h_{21}}$** - предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора.
- **$K_{ш}$** - коэффициент шума транзистора.
- **C_k** - емкость коллекторного перехода.
- **$C_э$** - емкость коллекторного перехода.
- **$T_p \max$** - максимально допустимая температура перехода.
- **$T \max$** - максимально допустимая температура окружающей среды.